

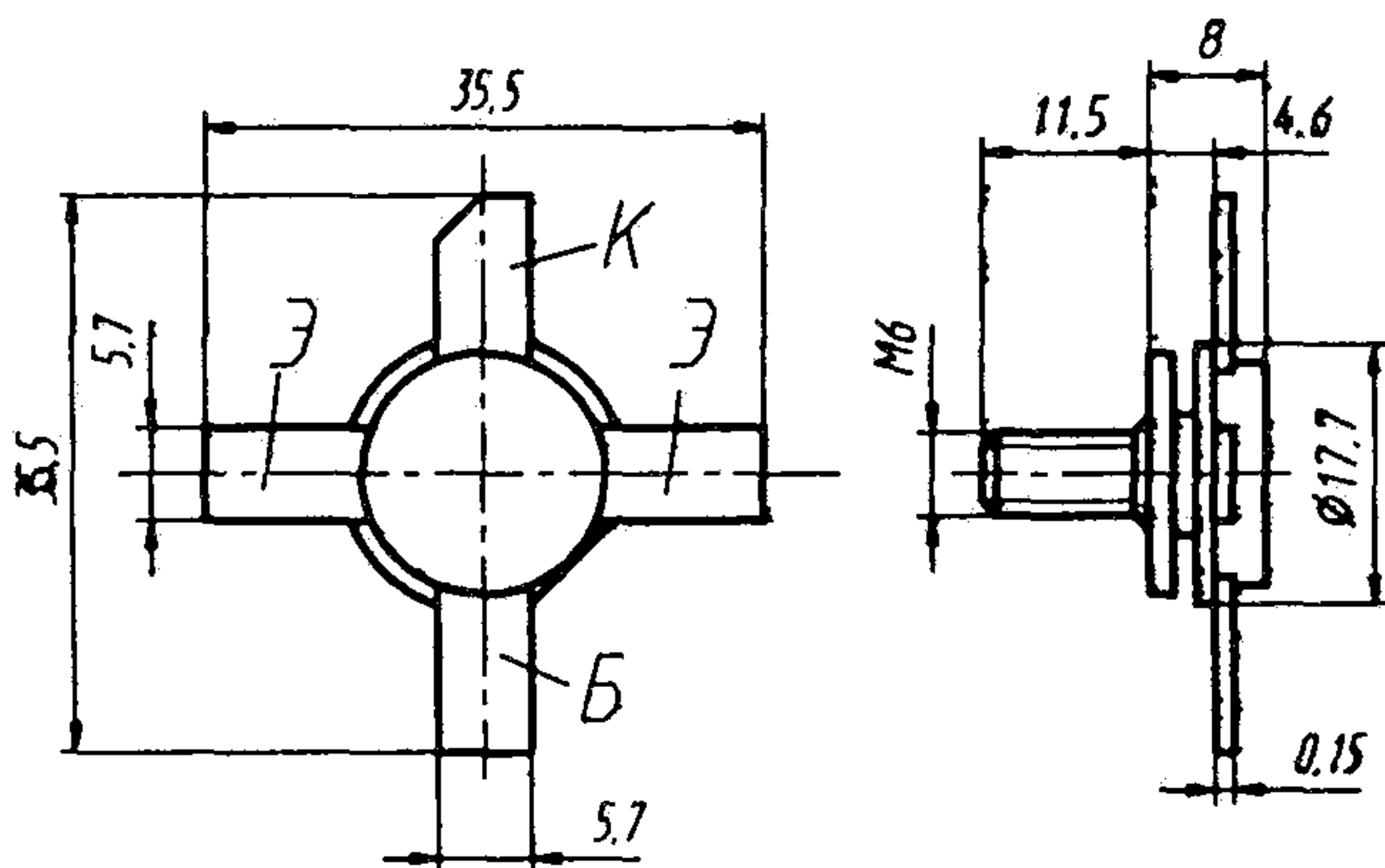
## А661А, А661Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные линейные. Предназначены для применения в широкополосных усилителях мощности в диапазоне частот 1,5...30 МГц для А661А и 30...80 МГц для А661Б в схеме с общим эмиттером при напряжении питания 50 В. Выпускается в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами и винтом. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 11 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

А661(А,Б)



### Электрические параметры

Выходная мощность на частоте  $f = 30$  МГц для А661А и на  $f = 80$  МГц для А661Б при  $U_{\text{п}} = 50$  В, не менее ..... 250 Вт

Коэффициент усиления по мощности в пике огибающей при  $P_{\text{вых}} = 250$  Вт,  $U_{\text{п}} = 50$  В, не менее:

А661А на  $f = 30$  МГц ..... 25

А661Б на  $f = 80$  МГц ..... 5

Коэффициент полезного действия коллектора в пике огибающей при  $P_{\text{вых}} = 250$  Вт,  $U_{\text{п}} = 50$  В, не менее:

А661А на  $f = 30$  МГц ..... 35%

А661Б на  $f = 80$  МГц ..... 30%

Коэффициент комбинационных составляющих 3-го и 5-го порядков при  $P_{\text{вых}} = 250$  Вт,  $U_{\text{п}} = 50$  В, не более:

А661А на  $f = 30$  МГц ..... -30 дБ

А661Б на  $f = 80$  МГц ..... -27 дБ

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{\text{кб}} = 10$  В,  $I_{\text{к}} = 5$  А, не менее:

А661А ..... 15

А661Б ..... 10

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{\text{кз}} = 20$  В,  $I_{\text{к}} = 9$  А, не менее ..... 150 МГц

Емкость коллекторного перехода при  $U_{\text{кб}} = 50$  В, не более ..... 450 пФ

Емкость эмиттерного перехода при  $U_{\text{эб}} = 0$ , не более ..... 15000 пФ

Обратный ток коллектор—эмиттер при  $U_{\text{кз}} = 90$  В,  $R_{\text{бз}} = 10$  Ом, не более ..... 100 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{\text{эб}} = 4$  В, не более ..... 500 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение питания ..... 50 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер ..... 90 В

Постоянное напряжение эмиттер—база ..... 4 В

Потенциал статического электричества ..... 1000 В

Постоянный ток коллектора ..... 15 А

Постоянный ток базы ..... 5 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:

при  $T_{\text{к}} = -60...+30$  °С ..... 300 Вт

при  $T_{\text{к}} = +125$  °С ..... 135 Вт

Средняя рассеиваемая мощность коллектора в динамическом режиме:

при  $T_{\text{к}} = -60...+30$  °С ..... 300 Вт

при  $T_{\text{к}} = +125$  °С ..... 135 Вт

Входная высокочастотная мощность, падающая на вход транзистора ..... 16 Вт

КСВН коллекторной цепи при  $P_{\text{вых}} = 100$  Вт, времени рассогласования 1 с и любой фазе коэффициента отражения ..... 30

Температура *p-n* перехода ..... +200 °С

Тепловое сопротивление переход—корпус ..... 0,57 °С/Вт

Температура окружающей среды .....  $-60...T_{\text{к}} = +125$  °С

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 3 мм от корпуса. Крутящий момент на монтажном винте должен быть не более 0,25 кг · м. Пайка выводов транзисторов рекомендуется не ближе 2 мм от корпуса при температуре не выше +260 °С в течение не более 8 с.